

Изобретение относится к полупроводниковой технике, в частности, к полупроводниковым приборам с переменной ёмкостью.

Полупроводниковый прибор варакторного типа на основе диода Шоттки включает полупроводниковую подложку, которая содержит структурированную область и омические контакты. Новизна устройства состоит в том, что структурированная область выполнена пористой, с порами, направленными перпендикулярно поверхности, при этом отношение глубины пористой области к расстоянию между порами больше десяти.

Способ изготовления полупроводникового прибора варакторного типа включает травление полупроводниковой подложки и осаждение металлического контакта Шоттки и омических контактов. Новизна способа состоит в том, что травление подложки осуществляется электрохимическим методом, а осаждение металлического контакта Шоттки проводится путём приложения импульсов напряжения в электролитическом растворе.

П. формулы: 2

Фиг.: 4